

DIODE-PENTODE with variable mutual conductance for use as R.F., I.F. and A.F. amplifier
DIODE-PENTODE à pente variable pour l'utilisation en amplificatrice H.F., M.F. et B.F.
DIODE-PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als H.F.-, Z.F.- und N.F.- Verstärker

Heating : indirect by A.C. or D.C.;
parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;
alimentation en parallèle

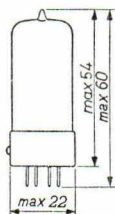
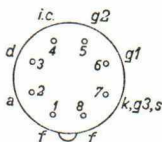
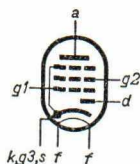
Heizung : indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom; Parallel-
speisung

$$V_F = 6,3 \text{ V}$$
$$I_f = 0,2 \text{ A}$$

Dimensions in mm

Dimensions en num

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Rimlock

Capacitances
Capacités
Kapazitäten

Pentode section
Partie penthode
Pentodenteil

Diode section
Partie diode
Diodenteil

$$C_a = 6,5 \text{ pF}$$
$$C_d = 3,8 \text{ pF}$$
$$C_{g1} = 4,0 \text{ pF}$$
$$C_{df} < 0,02 \text{ pF}$$
$$C_{ag1} < 0,002 \text{ pF}$$
$$C_{g1f} < 0,05 \text{ pF}$$

Between diode and pentode sections
Entre les parties diode et penthode
Zwischen Dioden- und Pentodenteil

$$C_{dg1} < 0,0015 \text{ pF}$$
$$C_{da} < 0,15 \text{ pF}$$

Operating characteristics of the pentode section as R.F. or I.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode en amplificatrice H.F. ou M.F.

Betriebsdaten des Pentodenteiles als H.F.-oder Z.F.-Verstärker

V_a	=	250	V
R_{g2}	=	95	k Ω
R_k	=	300	Ω
V_{g1}	=	$\overbrace{-2 \quad \quad \quad -40}$	V
I_a	=	5	mA
I_{g2}	=	1,6	mA
S	=	1800	$\mu A/V$
R_i	=	1,2	> 10 M Ω
μ_{g2g1}	=	19	-
R_{eq}	=	9,0	k Ω

Limiting values of the pentode section

Caractéristiques limites de la partie penthode

Grenzdaten des Pentodenteiles

V_{ao}	= max.	550 V
V_a	= max.	300 V
W_a	= max.	2 W
V_{g2o}	= max.	550 V
V_{g2} ($I_a < 2,5$ mA)	= max.	300 V
V_{g2} ($I_a = 5$ mA)	= max.	125 V
W_{g2}	= max.	0,3 W
I_k	= max.	10 mA
V_{g1} ($I_{g1} = +0,3$ μA)	= max.	-1,3 V
R_{g1}	= max.	3 M Ω
R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{kf}	= max.	50 V

Limiting values of the diode section

Caractéristiques limites de la partie diode

Grenzdaten des Diodenteiles

V_d invp	= max.	350 V
I_d	= max.	0,8 mA
I_{dp}	= max.	5 mA